

お客様各位

株式会社東芝 社会インフラシステム社  
コンポーネンツ&パーツビジネス推進部

## 東芝マイクロ波半導体製品のプロセス変更通知(PCN)

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。  
この度、弊社製品の規格の一部を変更しますのでご連絡致します。  
変更内容の詳細は下記のとおりです。

—記—

**1. 対象製品 :**

以下に記すマイクロ波半導体製品が対象となります。

TGI7785-50L

**2. 変更内容 :**

出力電力規定時のドレイン電流 IDS1 の最大値を 6.0A から 6.3A に変更致します。

**3. 変更理由 :**

マイクロ波電力 GaN HEMT の生産性向上のためです。

**4. 変更時期**

製品への適用は、出荷 Lot 3K1A (2013年10月製造分)以降となります。

以上